



性能特点：

- 频率范围：6~18GHz
- 噪声系数：1dB
- 增益：19.5dB
- 输入回波损耗：10dB
- 输出回波损耗：15dB
- 输出 P1dB : 15 dBm
- 单电源供电：+5V@76mA
- 芯片尺寸：1.35mm×0.98mm×0.1mm

产品简介：

XLN-0618 是一种 GaAs MMIC 超宽带低噪声放大芯片，其频率范围覆盖 6~18GHz，整个带内噪声系数典型值维持在 1dB，XLN-0618 采用+5V 供电。

电参数：(TA=25°C , Vd=+5V)

指标	最小值	典型值	最大值	单位
频率范围		6~18		GHz
噪声系数	0.8	1	1.3	dB
增益		19.5		dB
输出 P1dB		15		dBm
输入回波损耗		10		dB
输出回波损耗		15		dB

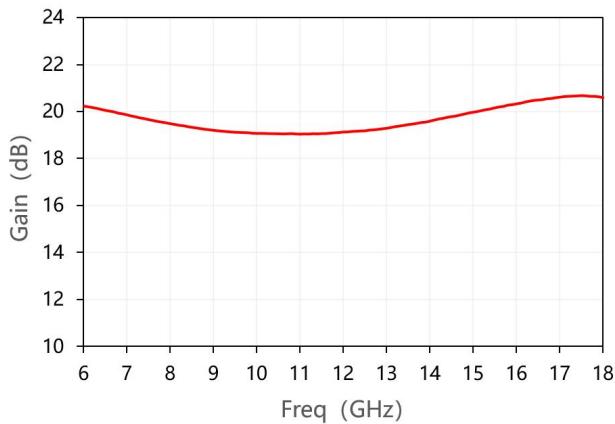
使用极限参数：

输入功率	+15dBm
控制电压	+7V
存储温度	-65°C~150°C
使用温度	-55°C~125°C

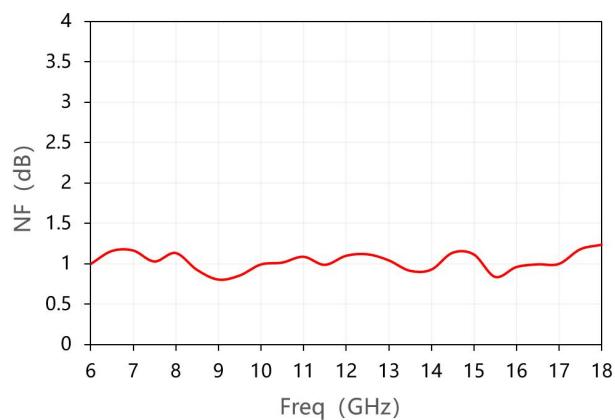


典型曲线：

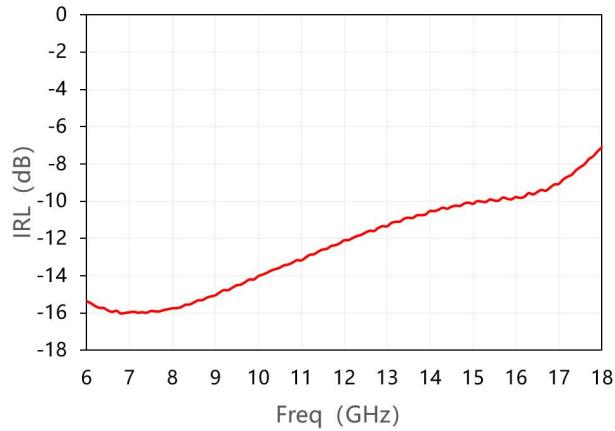
增益 VS 频率



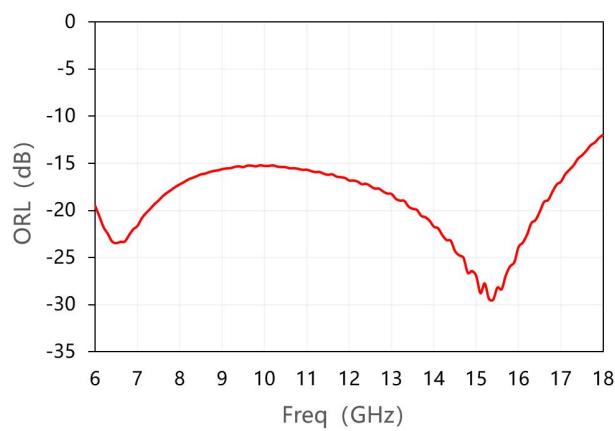
噪声系数 VS 频率



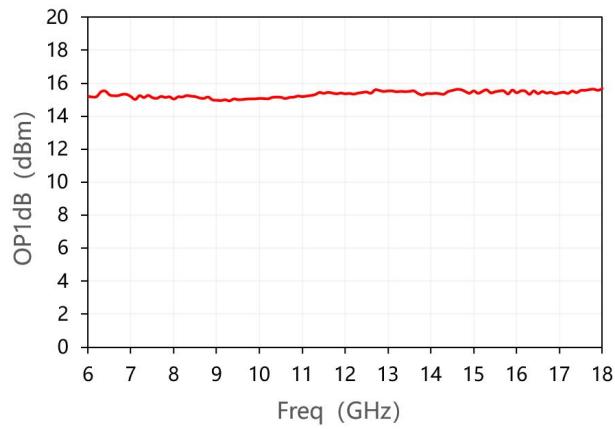
输入回波损耗 VS 频率



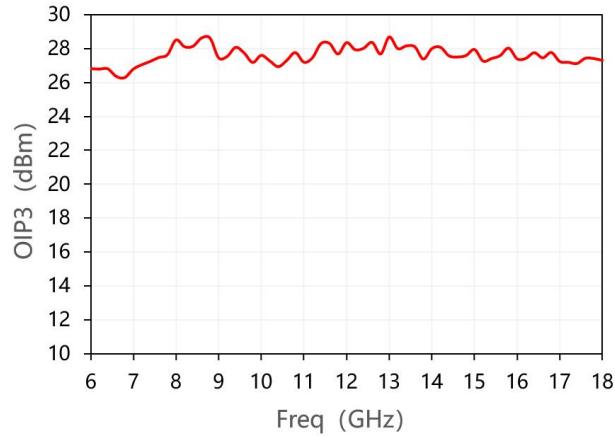
输出回波损耗 VS 频率



输出 1dB 压缩点 VS 频率

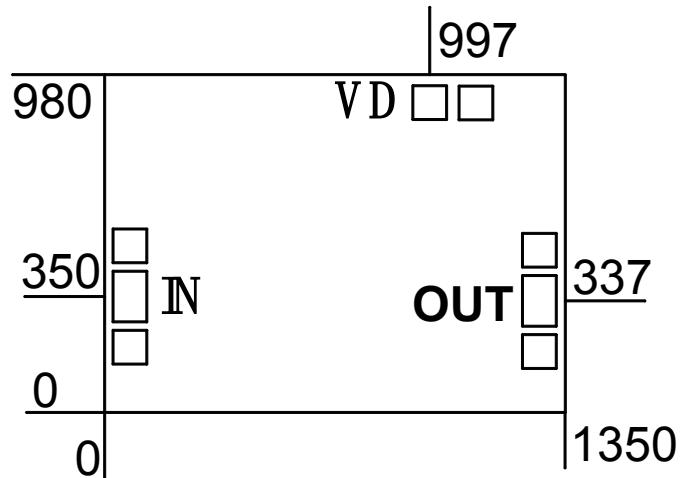


三阶交调点输出功率 VS 频率





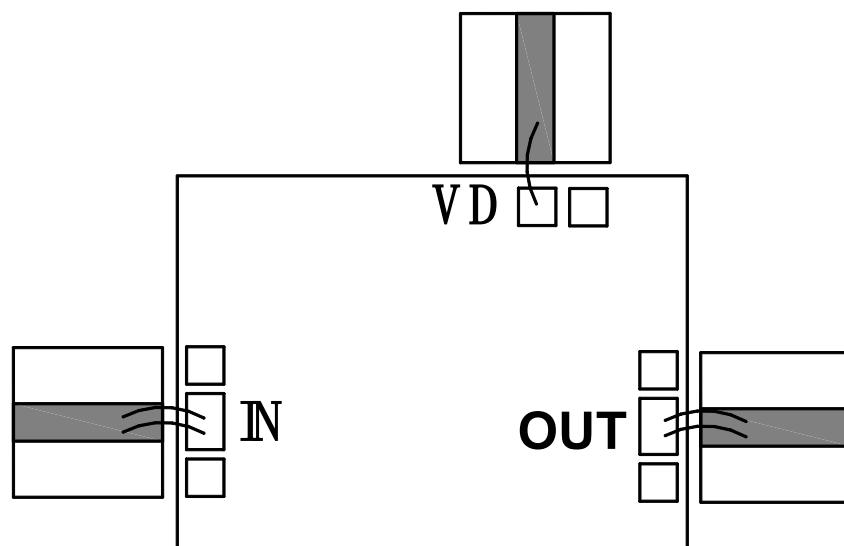
芯片尺寸图：(单位 μm)



管脚定义与功能：

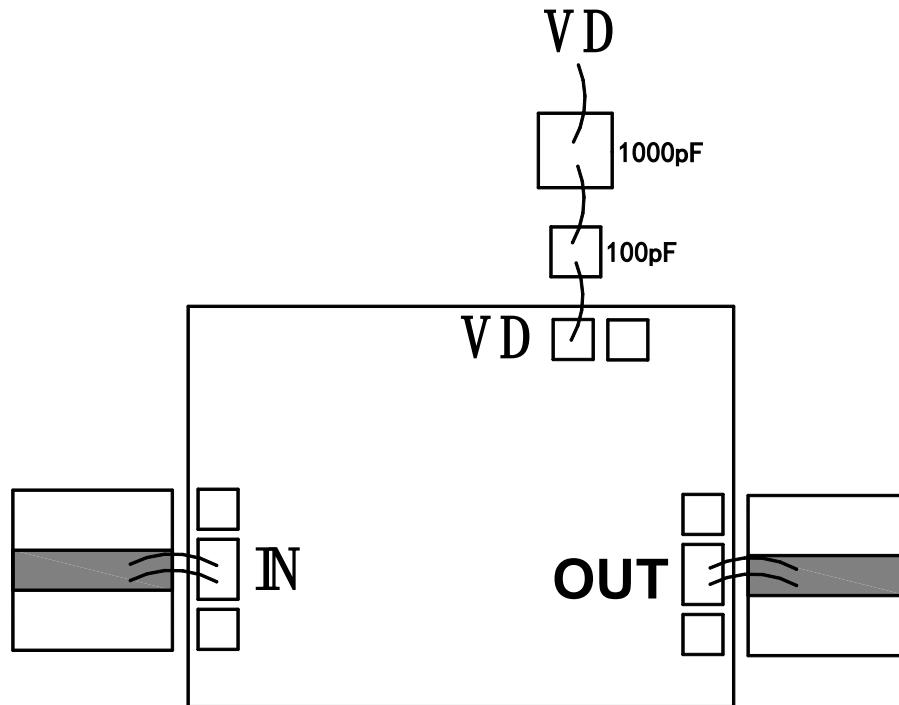
管脚	描述
RF IN	射频输入
VD	输入电压，典型值+5V
RF OUT	射频输出

芯片建议装配图：





应用电路建议：



使用注意事项：

- 1、芯片需要贮存在干燥洁净的 N₂环境中；
- 2、电路为静电敏感器件，请严格遵守 ESD 防护，避免裸芯片静电损坏；
- 3、使用时，芯片务必保证接地良好；
- 4、VD 和 RF 端口金丝长度 100μm 最佳；
- 5、建议使用直径 25μm 的金丝键合